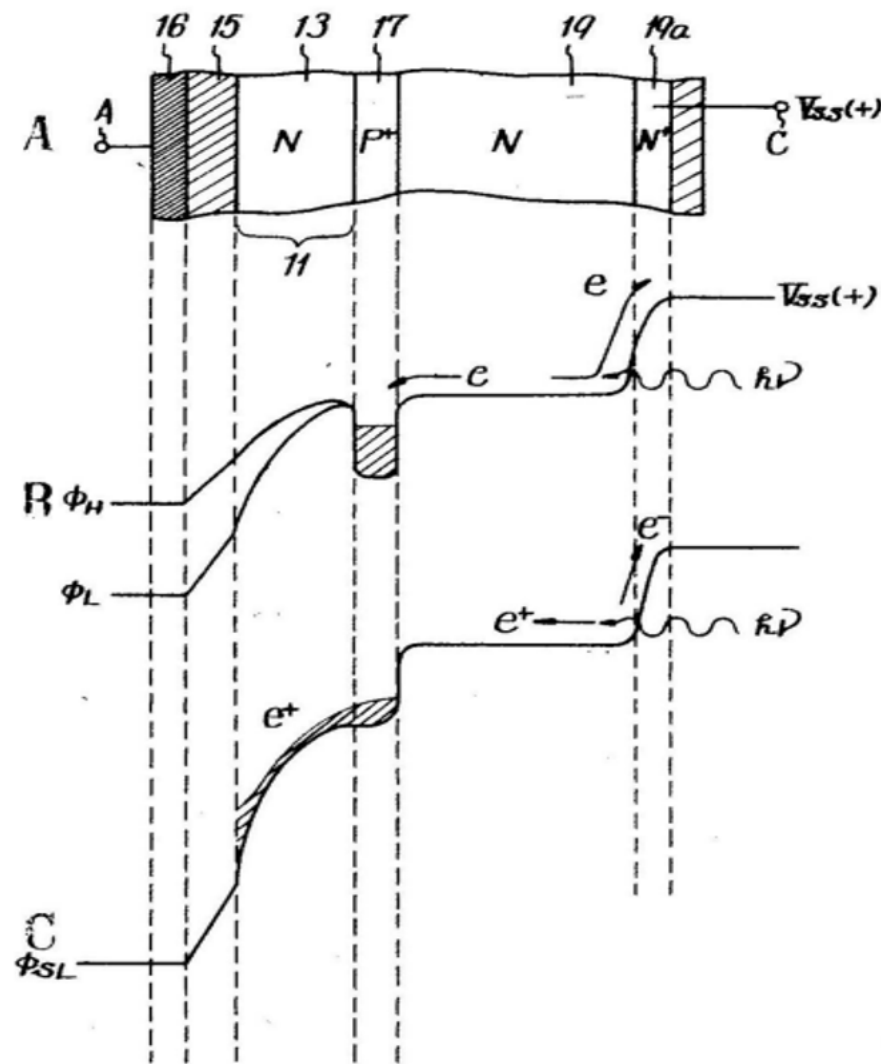


# JPA1975-127647 applied on Oct 23, 1975

Inventor Yoshiaki Hagiwara at Sony

First N+N-P+N junction Type  
 Pinned Buried Photodiode  
 with the MOS/CCD Capacitor Type  
 Global Shutter Buffer Memory  
 and P+ Buried Photo Charge Storage  
 with Completely Empty Potential Well  
 and Pinned N+N type Surface with Metal Contact  
 with Zero RC delay time constant  
 for high frequency electric shutter function.

第 7 図



特 許 願 (G)

昭和 50 年 10 月 23 日

特許庁長官 斎藤英雄 殿

1. 発明の名称 コトイサツソウソクチ  
 固体撮像装置
2. 発明者 ヨコヘツ ネド ナ カリバチヨウ  
 住所 神奈川県横浜市保土ケ谷区狩場町 303-159  
ヘバ ヘラ ヨシ アキ カリバダイ  
 氏名 萩原良昭 狩場台アパート 402 号室
3. 特許出願人

ソナガワ カシシタツ  
 東京都品川区北品川6丁目7番35号  
 (218) ソニー株式会社  
 代表者 盛出昭夫

## 公開特許公報

- ①特開昭 52-51816
- ④公開日 昭52.(1977) 4.26
- ②特願昭 50-127647
- ②出願日 昭50.(1975) 10.23
- 審査請求 未請求 (全6頁)

Figure 7 of JPA1975-127647